

10.5.2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application filed 2003 JUN 06 with this Office.

REC'D 06 JUN 2004

WIPO

PCT

出願年月日 2003年 9月 4日
Date of Application:

出願番号 特願2003-313158
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2003-313158]

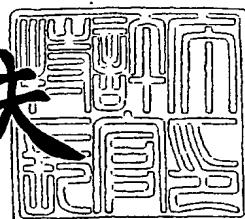
出願人 独立行政法人物質・材料研究機構
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 6月 18日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 02-MS-274R
【提出日】 平成15年 9月 4日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 C23C 14/06
【発明者】
【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学金属材料研究所内
【氏名】 関 剛斎
【発明者】
【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学金属材料研究所内
【氏名】 嶋 敏之
【発明者】
【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学金属材料研究所内
【氏名】 高梨 弘毅
【発明者】
【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研究機構内
【氏名】 宝野 和博
【特許出願人】
【識別番号】 301023238
【氏名又は名称】 独立行政法人物質・材料研究機構
【代表者】 岸 輝雄
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 特願2003- 87789
【出願日】 平成15年 3月27日
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

原子組成が、次式

Fe_xPt_{100-x}

(19 < x < 52)

で表わされることを特徴とするFePt磁性薄膜。

【請求項2】

100nm未満の膜厚でL1₀構造を有することを特徴とする請求項1のFePt磁性薄膜。

【請求項3】

単結晶基板またはその表面の酸化物下地層の上に成膜されていることを特徴とする請求項1または2のFePt磁性薄膜。

【請求項4】

下地層としての遷移金属および貴金属のうちの1種または2種以上による薄層を介して成膜されている請求項3のFePt磁性薄膜。

【請求項5】

薄層が、単層または多層であることを特徴とする請求項4のFePt磁性薄膜。

【請求項6】

薄層が、Fe、Ag、Ni、CoおよびCrのうちの1種または2種以上からなる層と、Au、Pt、およびCuのうちの1種または2種以上からなる層とにより構成されていることを特徴とする請求項5のFePt磁性薄膜。

【請求項7】

請求項1ないし6のいずれかのFePt磁性薄膜の製造方法であって、単結晶基板、酸化物下地層を設けた基板、あるいは下地層としての遷移金属および貴金属のうちの1種または2種以上による薄層を設けた基板に、温度240°C～500°Cの範囲でスパッタ成膜することを特徴とするFePt磁性薄膜の製造方法。

【請求項8】

温度300°C以下でスパッタ成膜することを特徴とする請求項7のFePt磁性薄膜の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】垂直磁気異方性を有するFePt磁性薄膜とその製造方法

【技術分野】

【0001】

この出願の発明は、垂直磁気異方性を有するFePt磁性薄膜とその製造方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

近年の高度情報化社会の発展に伴い、大量の情報を処理・記憶することのできる超高密度磁気記録媒体の開発が切望されている。磁気記録媒体に必要とされる特性には、磁気的に孤立した微粒子構造であること、この微粒子が熱擾乱に打ち勝つこと、一方向に配向していることが挙げられる。特に、磁気記録媒体の高密度化には、強磁性粒子のサイズを低減化する必要がある。しかしながら、強磁性微粒子のサイズを低減させると、室温において熱擾乱が支配的になる臨界粒径が存在するため、磁気記録が不安定になる。このような観点から、巨大な一軸結晶磁気異方性($K_u=7.0 \times 10^7 \text{ erg/cc}$)を有するL1₀構造FePt規則合金は、ナノサイズの超微細粒子であっても強磁性を維持でき、このため次世代の超高密度磁気記録媒体用材料として多くの注目を集めている。

【0003】

FePt規則合金はその高い一軸磁気異方性より磁石としての用途もある。FePtはNdやSm系などの希土類磁石と比較して、耐食性および耐酸化性に優れている。希土類磁石では耐食性や耐酸化性の向上のために元素を添加するが、この添加元素により磁気特性が劣化する。しかしFePtでは添加元素の必要が無く、FePtそのものの磁気特性が磁石特性に反映されるため、非常に有利である。このような耐食性に優れた薄膜磁石が実現されれば、超小型電磁気部品、マイクロマシン用超小型磁石、歯科用アタッチメント、神経等に局部的に磁界を印加する医科療法や体内へ微小量の薬品を投与するドラッグデリバリーシステム用のポンプなどへの応用が期待される。

【0004】

だが、L1₀構造は室温において熱力学的に安定であるが、スパッタ法により作製したFePt薄膜は、その作製過程において高温に存在する規則一不規則変態点を経ていないため規則構造に変態する（規則化する）ことができない。このため、L1₀規則構造を得るために加熱した基板上に成膜をおこなう、または成膜後の不規則合金薄膜を熱処理するなど、通常500°Cを超える高温プロセスが必要となる。しかしながら、現在ハードディスク装置に使用されている材料はそのような高温に対する耐性を有しておらず、高温プロセスは実用的な観点から大きな障害となっている。

【0005】

近年、そのプロセス温度を低減されるための合成法が多く報告されているが、これらの低温合成法は、第三元素添加による磁気特性の低下、結晶配向制御、プロセスの複雑化などの問題が生じる。また、これらの合成法の多くが主に化学量論組成のFe₅₀Pt₅₀、またはFe-richの組成でおこなわれている（非特許文献1）。

【0006】

また最近、高橋らは300°Cに加熱した基板にスパッタ成膜をおこなうことによりL1₀構造を持つFePt薄膜を低温合成することに成功しているが（非特許文献2、特許文献1）、その後の研究により、この低温合成には膜厚依存性があり、膜厚が100nm以上でなければ規則化が進みにくいことがわかつてきた。

【非特許文献1】M. Watanabe, M. Homma and T. Masumoto, Trans. J. Magn. Magn. Mater. 177, 1231 (1998)。

【非特許文献2】Y. K. Takahashi, M. Ohnuma, and K. Hono, Jpn. J. Appl. Phys. 40, L367 (2001)

【特許文献1】特開2003-99920号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

そこでこの出願の発明は、以上のとおりの従来技術の問題点を解消し、より低い温度での成膜が可能とされ、しかも垂直磁気異方性を有する新しいFePt磁性薄膜とその製造方法を提供することを課題としている。

【課題を解決するための手段】

【0008】

この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、第1には、原子組成が、次式

Fe_xPt_{100-x}

(19 < x < 52)

で表わされることを特徴とするFePt磁性薄膜を提供する。

【0009】

また、この出願の発明は、第2には、100nm未満の膜厚でL1₀構造を有することを特徴とする上記のFePt磁性薄膜を提供する。

【0010】

第3には、単結晶基板またはその表面の酸化物下地層の上に成膜されていることを特徴とするFePt磁性薄膜を、第4には、下地層としての遷移金属および貴金属のうちの1種または2種以上による薄層を介して成膜されているFePt磁性薄膜を、第5には、薄層が、単層または多層であることを特徴とするFePt磁性薄膜を、第6には、薄層が、Fe、Ag、Ni、CoおよびCrのうちの1種または2種以上からなる層と、Au、Pt、およびCuのうちの1種または2種以上からなる層とにより構成されていることを特徴とするFePt磁性薄膜を提供する。

【0011】

そして、この出願の発明は、第7には、以上のFePt磁性薄膜の製造方法であって、単結晶基板、酸化物下地層を設けた基板、あるいは下地層としての遷移金属および貴金属のうちの1種または2種以上による薄層を設けた基板に、温度240℃～500℃の範囲でスパッタ成膜することを特徴とするFePt磁性薄膜の製造方法を、第8には、温度300℃以下でスパッタ成膜することを特徴とするFePt磁性薄膜の製造方法を提供する。

【発明の効果】

【0012】

以上のとおりのこの出願の発明は、発明者による検討の結果得られた全く新しい知見に基づいて完成されている。すなわち、スパッタ法によりFePt薄膜を作製する際に、組成を $Fe_{50}Pt_{50}$ (at. %) の化学量論組成からPt-rich側にずらすことにより、膜面垂直方向に配向し、かつ結晶磁気異方性が大きいFePt規則合金薄膜の低温合成を可能としている。

【0013】

すなわち、この出願の発明では、低温におけるFePtの規則化の組成依存性に着目し、スパッタ法を用いて実用的な基板温度において広範囲な組成領域のFePt薄膜の成膜を可能とし、FePt薄膜の膜厚依存性がなく、10nm以下の超薄膜においてもL1₀構造のFePtを成膜可能としている。さらに基板とエピタキシャル成長させることにより、膜面垂直方向に一軸磁気異方性を有するL1₀構造FePt薄膜を創製することにより成功している。従来の低温製造法と比して、FePt相の組成を変化させるだけの簡便な手法により、配向制御されたL1₀構造FePt規則合金薄膜が低温で作製できることが大きな違いである。また、この簡便な手法により非常に大きな結晶磁気異方性を実現している。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

この出願の発明は上記のとおりの特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態について説明する。

【0015】

まず、この出願の発明におけるFePt磁性薄膜については、高い一軸磁気異方性をしめす組成領域が必要である。そのため、FePt相の合金組成（原子比）を Fe_xPt_{100-x} で $19 < x <$

52とすることが必要である。

【0016】

また、超小型電子部品などへの工業的な応用を考慮すると、膜厚をできるだけ薄くすることが望ましい。この出願の発明によれば、従来法と異なり、100nmの膜厚を必要とせず、2nmから100nmの範囲でL1₀構造の薄膜を成膜することができる。

【0017】

基板上に成膜されるFePt薄膜に磁気異方性を付与するためには、結晶方向を制御することが必要とされるが、これは単結晶基板を選択することで容易に可能となる。磁化容易軸を垂直に配向させるにはMgO(001)のほかにNaCl(001)、GaAs(001)などが好適な単結晶基板として挙げられる。また、単結晶以外のガラス基板等の各種のものを用いた場合においても、MgOまたはZnO等の酸化物の下地層をこれら基板の表面に配設することにより配向制御が容易となる。

【0018】

この出願の発明においては、FePt薄膜の成膜に際しては、基板、そしてその表面上に配設される酸化物やその他の物質からなる下地層の選択が重要となる。

【0019】

規則相が得られるFePt相に対する基板や下地層の選択については、FePt相の配向制御および規則化の促進の観点も考慮される。この出願の発明においては、このような観点から、基板（好適には単結晶基板または酸化物下地層を有する基板）の上に、下地層としての、遷移金属または貴金属のうちの1種または2種以上による薄層を介してFePt磁性薄膜を成膜することも考慮される。

【0020】

この場合の薄層は単層または多層でよいが、薄層が、Fe、Ag、Ni、CoおよびCrのうちの1種または2種以上からなる層（これをシード層と呼ぶことができる）と、Au、Pt、およびCuのうちの1種または2種以上からなる層（バッファー層と呼ぶことができる）とにより構成されていることがより好適な形態として考慮される。シード層については、0.2から2nmの膜厚が、また、バッファー層については、5～50nmの膜厚が好適なものとして考慮される。

【0021】

これらの遷移金属の貴金属の下地層については、FePt層との格子不整合の大きな下地層を選択することで、Ptリッチ側組成領域において、より高い規則度および大きな垂直磁気異方性が得られることが考慮される。また、選択する下地層により異方性の制御が可能である。

【0022】

もちろん、以上のような下地層の配設は必ずしも必要ではない。FePt相の規則化の観点から、組成や成膜条件を設定することで、FePt薄膜の配向制御が可能とされる。たとえば、後述の実施例にも示したように、シード層やバッファー層という下地層を用いなくとも、MgO(001)単結晶基板上のFePt層は配向制御され、Ptリッチ側組成領域において240℃～500℃の温度範囲で規則化が進行する。この際の配向制御のために、たとえば好適にはAr（アルゴン）ガス圧を3mTorr～40mTorrの範囲としてスパッタ成膜することが考慮される。

【0023】

この出願の発明のFePt磁性薄膜は、従来に比べてより低い温度でのスパッタ法により製造されるが、FePt成膜時において、規則相および大きな一軸磁気異方性を実現するためにはある程度の基板温度が必要となる。一方、実用的な観点からはプロセス温度は低温である必要がある。そのためには基板温度を240℃から500℃の範囲として成膜する必要があるが、300℃以下の低温合成が可能なことがこの出願の発明の最大の特徴である。

【0024】

また、高保磁力を有する材料を記録媒体に応用した場合、情報の書き込み（磁化の反転）に対して高磁場が必要となる。そこで、熱アシスト型磁気記録方式が提案されている。

記録媒体をレーザー光などで局所的に加熱することにより、キュリー温度付近まで磁性体の温度を上昇させ、部分的に磁化（情報）を消失させる。このときに外部から磁場を印加しておくことにより、冷却後にその磁場の向きに磁化することができる。このような情報記録方式の動向を考慮すると、キュリー温度を制御することは、熱アシスト方式の磁気記録などへの応用に際して重要となる。そこで、この出願の発明のFePt薄膜の特徴が生かされることになる。すなわち、Ptリッチ側組成領域において、バルク値よりも低いキュリー温度Tcを有するFePt規則合金薄膜の低温合成が可能とされることである。また組成を調整することにより、任意にTcを制御することができる。

【0025】

そこで以下に実施例を示し、さらに詳しく説明する。もちろん、以下の例によって発明が限定されることはない。

【実施例】

【0026】

<実施例1>

到達真空度 1×10^{-9} Torr以下のUHV対応マグネットロンスパッタリング装置を用い、MgO(001)単結晶基板上にArガス圧1mTorrでFeシード層を1nm、Ptバッファー層を40nm室温で成膜し、その後基板温度300°CとしてArガス圧5mTorrで18nmの膜厚でスパッタ成膜した。図1は、得られたFePt薄膜のX線回折パターンを示したものである。 $Fe_{x}Pt_{100-x}$ 相は、 $x = 68$ (a), 62(b), 52(c), 45(d), 38(e), 34(f), 30(g), 19(h)の組成となっている。 $(00n)$ の回折ピークのみを観測できることから、MgO(001)基板上にFePt層がMgO(001) // FePt(001)の方位関係を持って成長していることがわかる。すべての組成のFePt薄膜においてFePt相の基本反射線である(002)および(004)回折ピークと、バッファー層のPt(002)と(004)回折ピークが観測される。 $x < 45$ のFePt薄膜において、FePtの超格子反射線である(001)および(003)回折ピークを観測することができ、 $L1_0$ 構造のFePt規則合金が得られていることが確認される。 $x = 38$ のFePt薄膜において超格子反射線の積分強度が最も大きくなり、規則化が最も進行していることがわかる。化学量論組成である $Fe_{50}Pt_{50}$ 薄膜では超格子反射線が観測されず、化学量論組成のFePt薄膜においては300°Cという基板温度は規則化をするには低い温度であることがわかる。しかしながらFePt薄膜の組成をPt-rich側にずらすことで規則化が進行し、300°Cの基板温度においても $L1_0$ 規則構造が得られていることがわかる。低温では、 $19 < x < 52$ の組成領域でFePtの規則化が進行することが明らかとなった。

【0027】

<実施例2>

実施例1と同様にして、MgO(001)単結晶基板上にFeシード層を1nm、Ptバッファー層を40nm室温で成膜し、その後基板温度300°CとしてFePt層を18nmの膜厚で成膜した。図2には、試料の膜面内方向および膜面垂直方向に測定した磁化曲線を示したものである。 Fe_xPt_{100-x} 相は、 $x = 52$ (a), 45(b), 38(c), 34(d), 30(e), 19(f)の組成となっている。 $x = 52$ のFePt薄膜は膜面内方向が磁化容易軸となっているが、 x を減少させるにつれて磁化容易軸が膜面垂直方向に変化していることがわかる。 $x = 38$ のFePt薄膜の膜面内方向と膜面垂直方向の磁化曲線によって囲まれた領域から算出した結晶磁気異方性定数Kuは、 1.8×10^7 erg/ccと非常に大きな値であった。 $19 < x < 52$ の組成領域において、膜面垂直方向に一軸磁気異方性を有するFePt薄膜が合成可能であることを明らかにした。

【0028】

<実施例3>

図3には、実施例1と同様にして、MgO(001)単結晶基板上にFeシード層を1nm、Ptバッファー層を40nm室温で成膜し、その後基板温度300°Cとして18nmの膜厚で成膜した Fe_xPt_{100-x} 相のa軸とc軸方向の面間隔、そのc軸とa軸の軸比c/a、規則度S、および結晶磁気異方性定数Kuの組成依存性を示した。 x を38まで増加させることで、c面の面間隔は単調に減少し、その後 $38 \leq x \leq 68$ の範囲では一定の値を保っている。一方、a面の面間隔は $38 \leq x$ の範囲で一定値をとっており、 $x \geq 38$ においては減少している。c/aからは結晶格子の歪の程度を評価することができる。c/aの値は $x = 38$ において極小値である0.

955を示し、そのときにS、Ku共に極大値をとっていることがわかる。

【0029】

＜実施例4＞

図4には、実施例1と同様にして、MgO(001)単結晶基板上にFeシード層を1nm、数種の金属・合金のバッファー層を40nm室温で成膜し、その後基板温度300°Cとして18nmの膜厚で成膜したFe₃₈Pt₆₂薄膜のX線回折パターンを示した。バッファー層はAu、AuPt、およびPtを選択した。いずれのバッファー層を用いても、他の面からの回折線は見えずFePt相の超格子反射線である(001)および(003)回折ピークを明瞭に観測することができる。このことより、FePtとの格子ミスフィットの小さなバッファー層を選択することで、L₁₀構造を有するFePt規則合金薄膜の低温合成が可能であることを明らかにした。

【0030】

＜実施例5＞

図5には、実施例1と同様にして、MgO(001)単結晶基板上にFeシード層を1nm、バッファー層を40nm室温で成膜し、その後基板温度300°Cとして18nmの膜厚で成膜したFePt薄膜の磁化曲線を示した。バッファー層はAu、AuPt、およびPtを選択した。Fe_xPt_{100-x}の組成はx=38または52とした。いずれのバッファー層を用いた場合において、Fe₃₈Pt₆₂薄膜の磁化容易軸が膜面垂直方向となっており、磁化曲線から算出される結晶磁気異方性定数は、Fe₅₂Pt₄₈薄膜のそれよりも大きな値となっていることがわかる。また、FePtとの格子ミスフィットがPtよりも大きいAuをバッファー層として選択した場合、下地層からの歪の影響により、Ptのバッファー層を用いた場合よりも大きな結晶磁気異方性を有していることがわかる。このことから、バッファー層の選択により異方性を制御することが可能であることがわかる。

【0031】

＜実施例6＞

図6には、実施例1と同様にして、MgO(001)単結晶基板上にFeシード層を1nm、Ptバッファー層を40nm室温で成膜し、その後基板温度300°Cとして膜厚tを変化させて成膜したFe₃₈Pt₆₂薄膜のX線回折パターンを示した。FePt層の膜厚tは9nmから54nmと変化させた。いずれの膜厚においても、FePt相の超格子反射線である(001)および(003)回折ピークが観測されることから、L₁₀構造を有するFePt規則合金薄膜が得られている。また膜厚の増加によりL₁₀規則構造に起因するピーク強度が増加していることから、より規則度の高いFePt薄膜が得られていると考えられる。

【0032】

＜実施例7＞

図7には、実施例1と同様にして、MgO(001)単結晶基板上にFeシード層を1nm、Ptバッファー層を40nm室温で成膜し、その後基板温度300°Cとして膜厚tを変化させて成膜したFe₃₈Pt₆₂薄膜の磁化曲線を示す。FePt層の膜厚tは9nmから54nmと変化させた。いずれのFePt層の膜厚においても、磁化容易軸が膜面垂直方向となっており一軸磁気異方性を持っていることが確認される。また膜厚の増加により困難軸方向（この場合、膜面内方向）の磁化の飽和性が悪くなっていることから結晶磁気異方性が増加していると考えられる。

【0033】

＜実施例8＞

図8には、実施例1と同様にして、MgO(001)単結晶基板上にFeシード層を1nm、Auバッファー層を40nm室温で成膜し、その後基板温度240°Cと300°Cとして18nmの膜厚で成膜したFe₃₈Pt₆₂薄膜のX線回折パターンを示した。基板温度240°CのFe₃₈Pt₆₂薄膜のX線回折パターンから、FePt相の超格子反射線である(001)および(003)回折ピークを観測することができる。このことから、成膜時の基板温度が240°C以上の条件において規則化が進行することが明らかとなった。

【0034】

＜実施例9＞

MgO(001)単結晶基板に対し、Arガス圧5mTorr、温度300°Cの条件下にUHVマグネット

ロンスパッタリングにより、FePt薄膜を18nm厚みで直接に成膜した。

【0035】

図9は、この薄膜のX線回折パターンを例示したものである。 Fe_xPt_{100-x} において、 $x=52$ （化学量論組成）、 $x=38$ （非化学量論組成）の薄膜のものを示している。

【0036】

$MgO(001)$ 基板上に成膜したFePt薄膜の結果から、 $FePt(00n)$ 回折ピークのみ観測されることから、試料薄膜が(001)配向していることが確認される。化学量論組成付近の $Fe_{52}Pt_{48}$ 薄膜では、明瞭な $FePt(001)$ および(003)超格子反射線を観測することができず、規則化が進行していない。しかしながらPtリッチ側の組成領域である $Fe_{38}Pt_{62}$ 薄膜においては、明瞭な超格子反射線を観測することができ、 $L1_0$ 規則構造が形成されていることが確認される。

【0037】

また図10は、実線が膜面垂直方向に測定した磁化曲線、破線が膜面内方向に測定した結果を示した図である。 $Fe_{52}Pt_{48}$ 薄膜では、膜面垂直方向への垂直磁気異方性を有していないが、Ptリッチ側の組成である $Fe_{38}Pt_{62}$ 薄膜では、 $Ku=2.7\times 10^7$ erg/ccという大きな垂直磁気異方性を有している。

【0038】

たとえば以上の結果から、シード層およびバッファー層を用いなくとも、 $MgO(001)$ 単結晶基板上にFePt層の配向制御を行うことにより、 Fe_xPt_{100-x} (in at. %)で $19 < x < 52$ のPtリッチ側組成領域において、240~500°Cの温度範囲で規則化が進行することがわかる。また、このとき配向制御を行うために、成膜中のArガス圧は3mTorrから40mTorrとすることが好ましいことも確認されている。

【0039】

＜実施例10＞

実施例1と同様にして、各種の下地層を有するFePt薄膜を作成した。これら薄膜について、格子不整合の影響について検討した。図11はその結果を示したものであって、Ptリッチ側の組成領域である $Fe_{38}Pt_{62}$ 薄膜では、格子不整合の大きな下地層を用いることにより、より大きな一軸磁気異方性エネルギーが得られること、一方、化学量論組成付近の $Fe_{52}Pt_{48}$ 薄膜では、垂直磁気異方性を得るために最適な下地層との格子不整合が存在することがわかる。

【0040】

＜実施例11＞

$MgO(001)$ 基板に、UHV-マグネットロンスパッタにより、Arガス圧5mTorr、温度300°Cの条件下に、Feシード層(1nm)、Ptバッファー層(40nm)およびFePt薄膜(18nm)を成膜した。この際の組成は、次の6種類とし、各々の場合の磁化の温度依存性を評価した。

【0041】

Fe_xPt_{100-x} :

$x=30, 34, 38, 45, 52, 62$

図12は、このPtバッファー層を用いた低温合成FePt薄膜における磁化の温度依存性を示したものである。高い規則度および大きな一軸磁気異方性を有していた $Fe_{38}Pt_{62}$ 薄膜の T_c は320°Cである。これは、化学量論組成のバルク試料において報告されている $T_c=480$ °C(P. phys. Z., 36(1935)544)よりも低い値である。これより、Ptリッチ側の組成領域において、高規則度・高磁気異方性、およびバルク値よりも低いキュリー温度を有するFePt規則合金薄膜が低温で合成できることがわかる。

【0042】

また、図13は、Ptバッファー層を用いた低温合成FePt薄膜のFe濃度 x (at. %)に依存したキュリー温度 T_c の変化を示したものである。X線回折パターンより不規則構造であると考えられる $x=62$ の試料では、 T_c の値が不規則相の文献値(ASM, International, USA, (1995), p-371)と一致している。化学量論組成付近である $x=52$ では、規則相の T_c と不規

則相のTcの中間値をとっており、十分に規則化が進行していないことがわかる。x=38において、規則相の文献値とほぼ一致するTcの値が得られている。

【産業上の利用可能性】

【0043】

以上詳しく述べたとおり、この出願の発明によって、簡便なプロセスであることに加え、より低温でのプロセスによって、大きな一軸磁気異方性を有するFePt薄膜が提供される。磁気記録媒体としての薄膜について、従来に比べて大変に有利な技術が提供されることになる。

【0044】

情報ストレージデバイスの中でもハードディスク装置は特に重要であり、大容量磁気記録媒体を期待する市場が既に存在しているが、この市場に対するこの出願の発明の寄与は大変に大きなものとなる。

【図面の簡単な説明】

【0045】

【図1】実施例1のFePt薄膜のX線回折パターンを示した図である。

【図2】実施例2における磁化曲線を示した図である。

【図3】実施例3におけるFePt薄膜の、a軸とc軸方向の面間隔、c/a（軸比）、規則度S、および結晶磁気異方性定数Kuの組成依存度を示した図である。

【図4】実施例4におけるFe₃₈Pt₆₂薄膜のX線回折パターンを示した図である。

【図5】実施例5におけるFePt薄膜の磁化曲線を示した図である。

【図6】実施例6におけるFe₃₈Pt₆₂薄膜のX線回折パターンを示した図である。

【図7】実施例7におけるFe₃₈Pt₆₂薄膜の磁化曲線を示した図である。

【図8】実施例8におけるFe₃₈Pt₆₂薄膜のX線回折パターンを示した図である。

【図9】実施例9におけるX線回折パターンを示した図である。

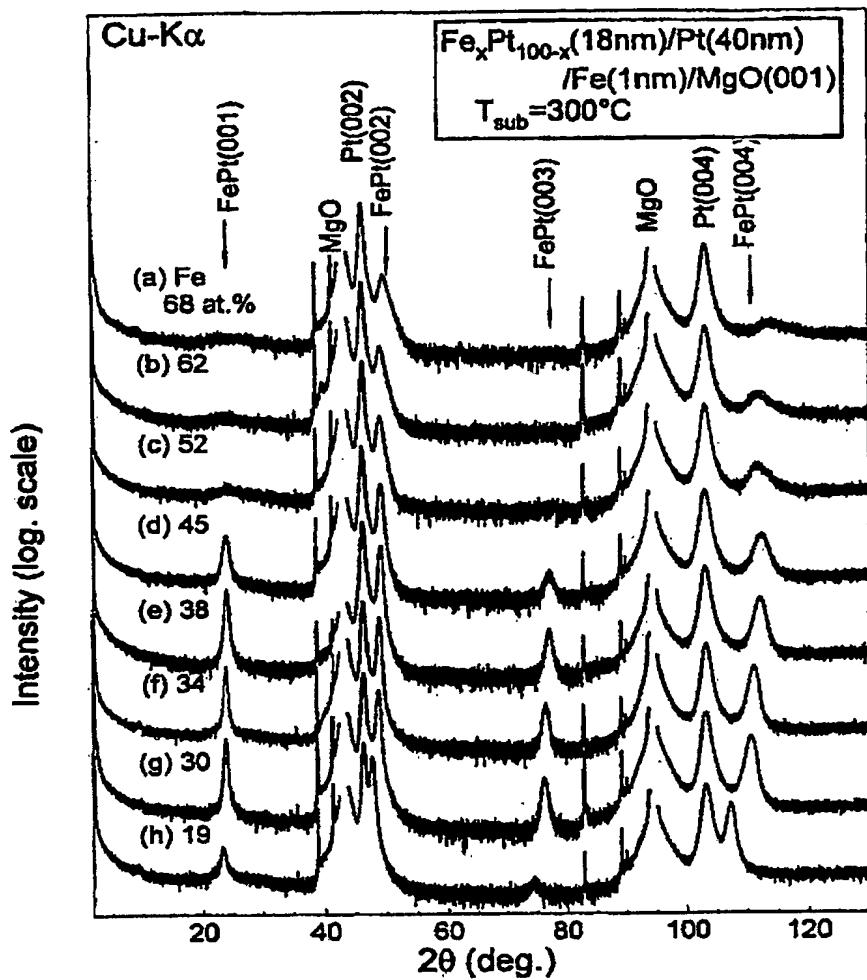
【図10】実施例9における磁化曲線を示した図である。

【図11】実施例10におけるKuと格子不整合との関係を示した図である。

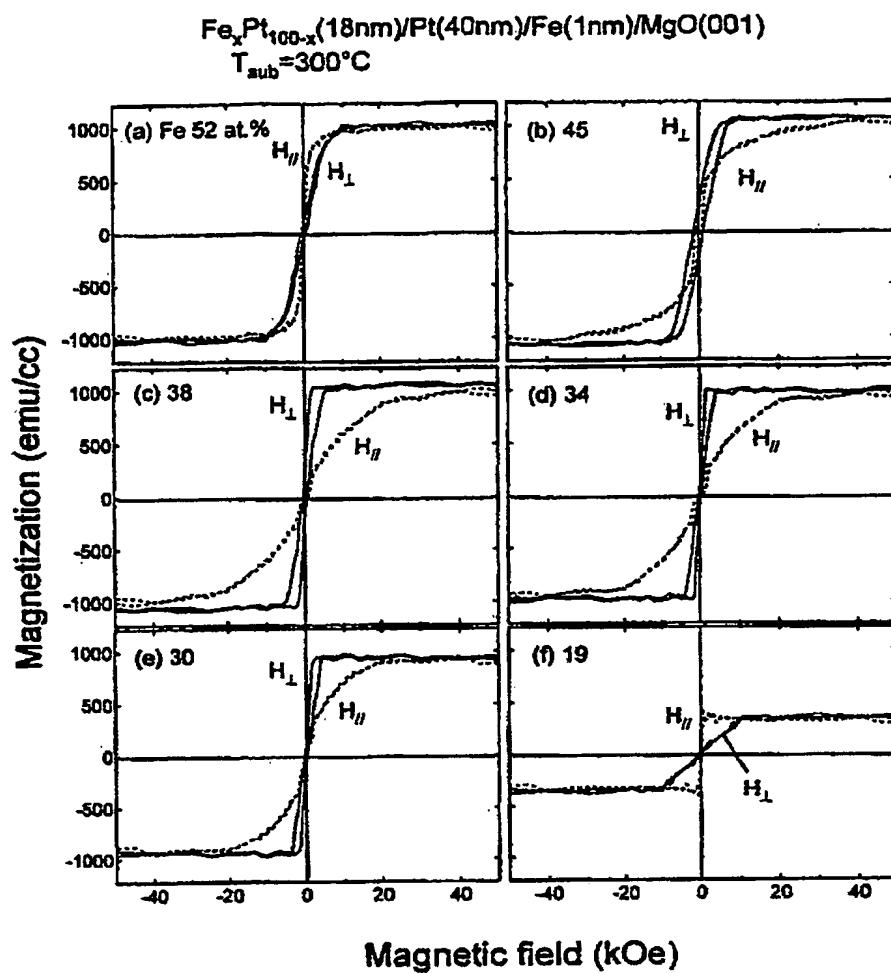
【図12】実施例11における磁化の温度依存性を示した図である。

【図13】実施例11におけるFe濃度とキュリー温度Tcとの関係を示した図である。

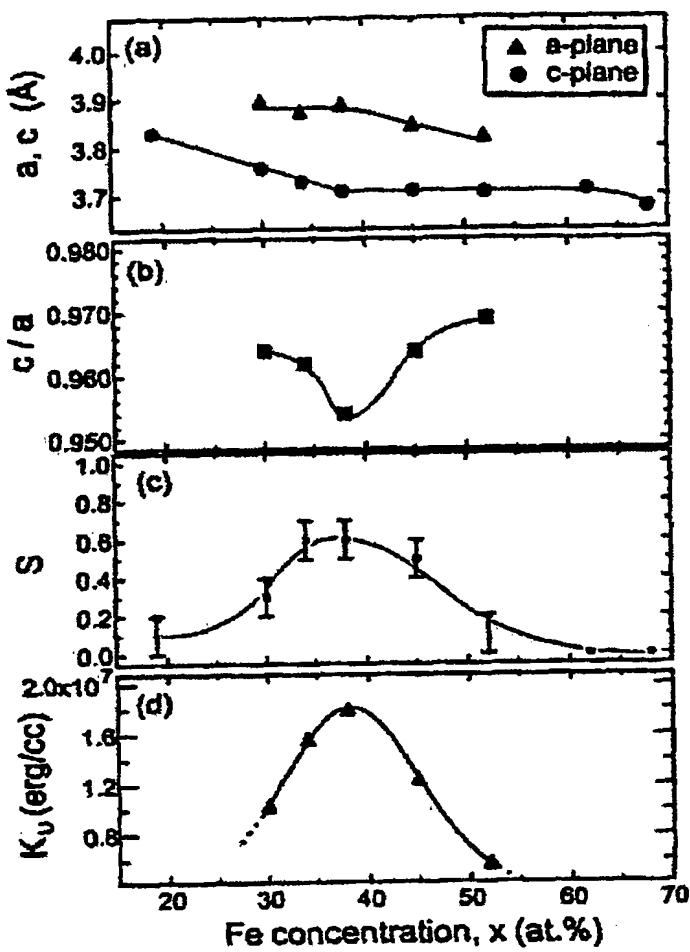
【書類名】図面
【図1】



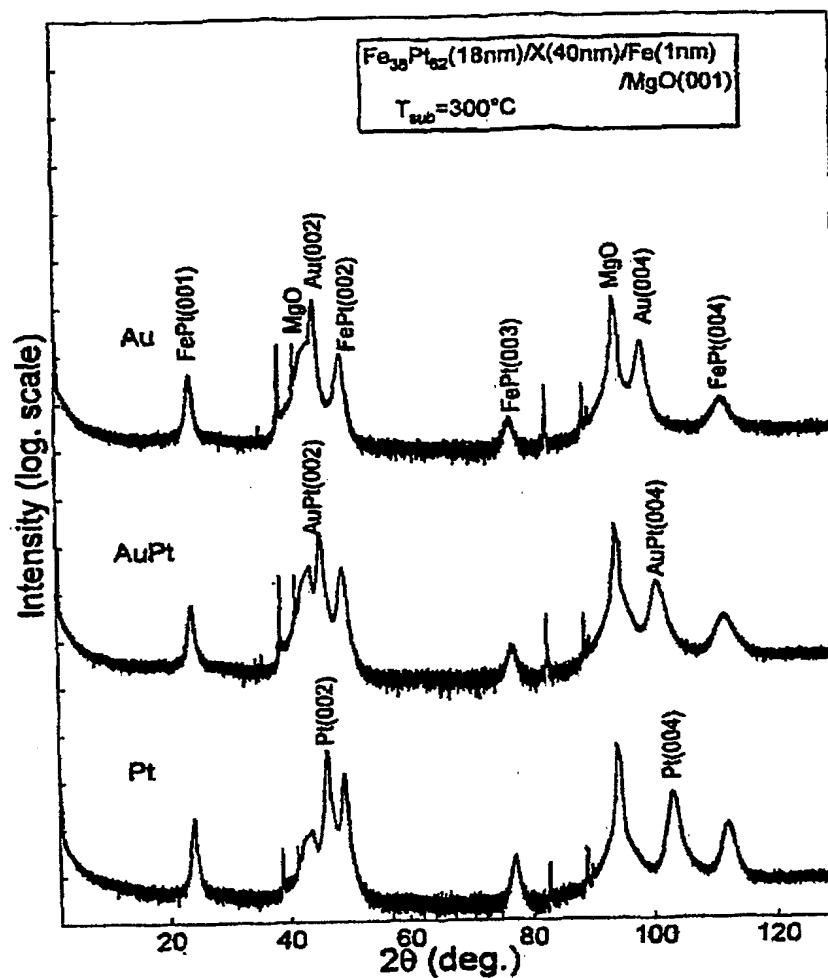
【図 2】



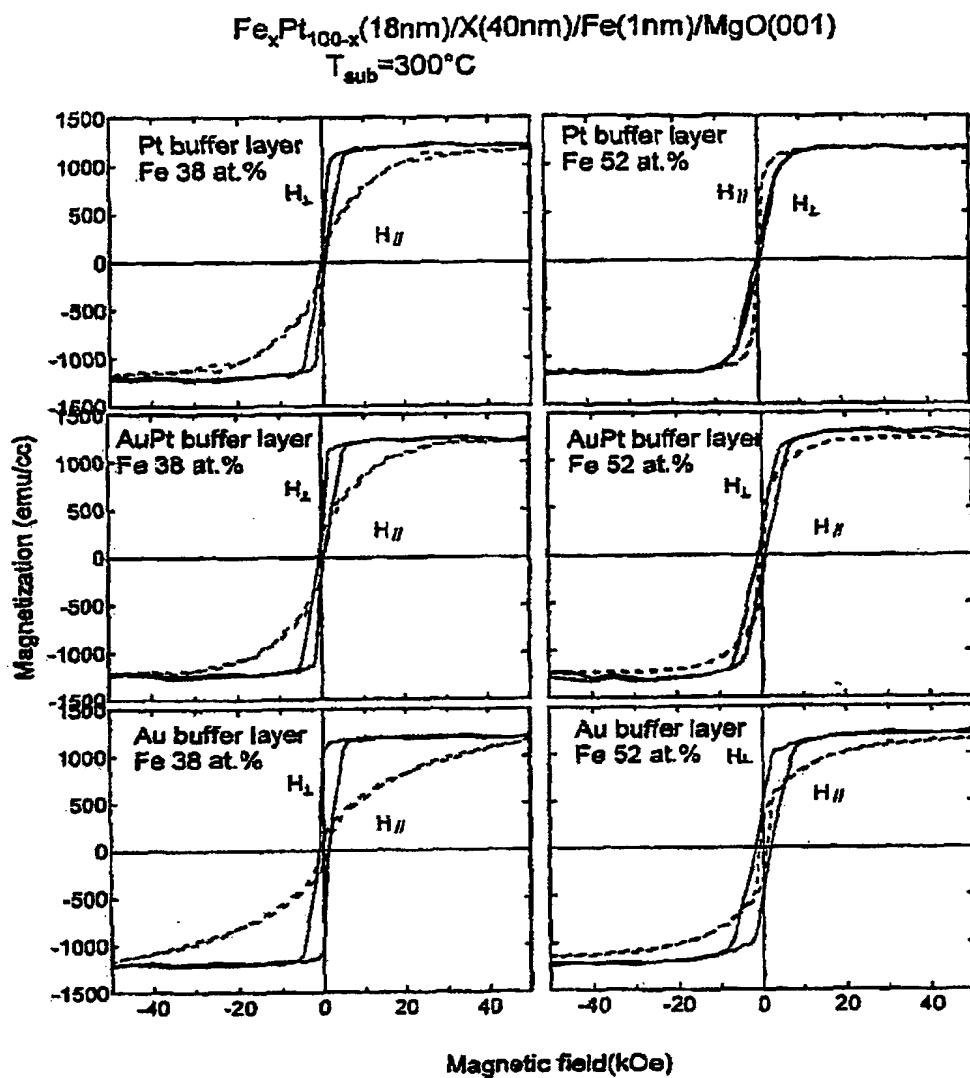
【図3】



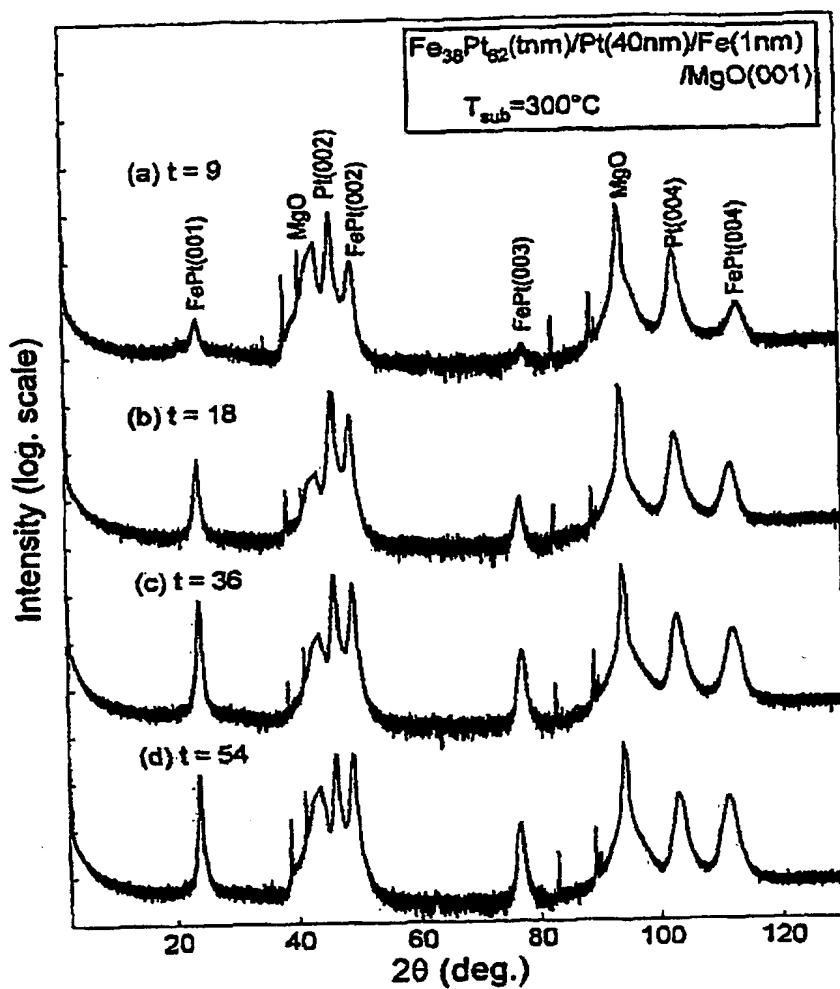
【図4】



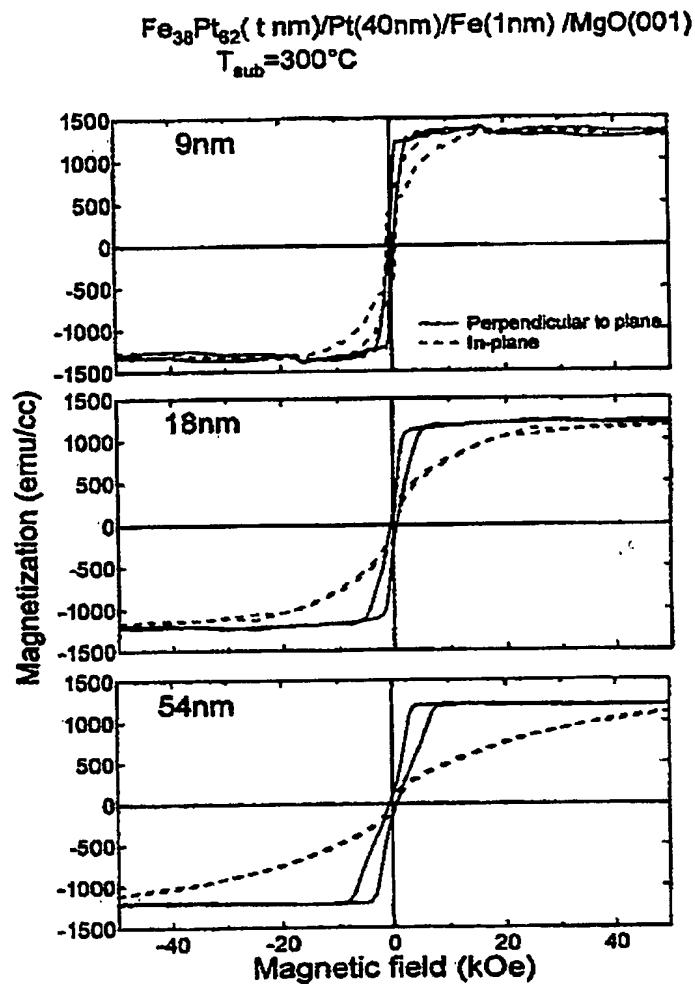
【図5】



【図6】

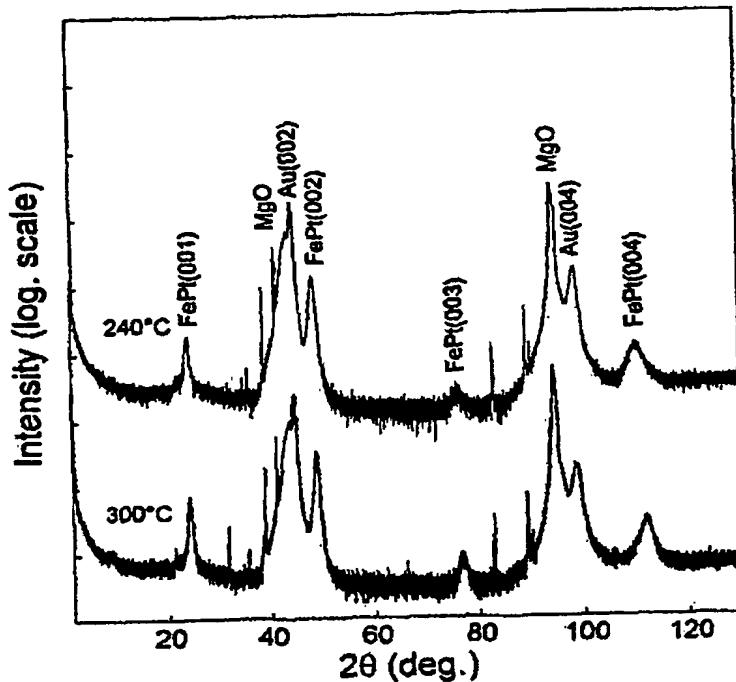


【図 7】

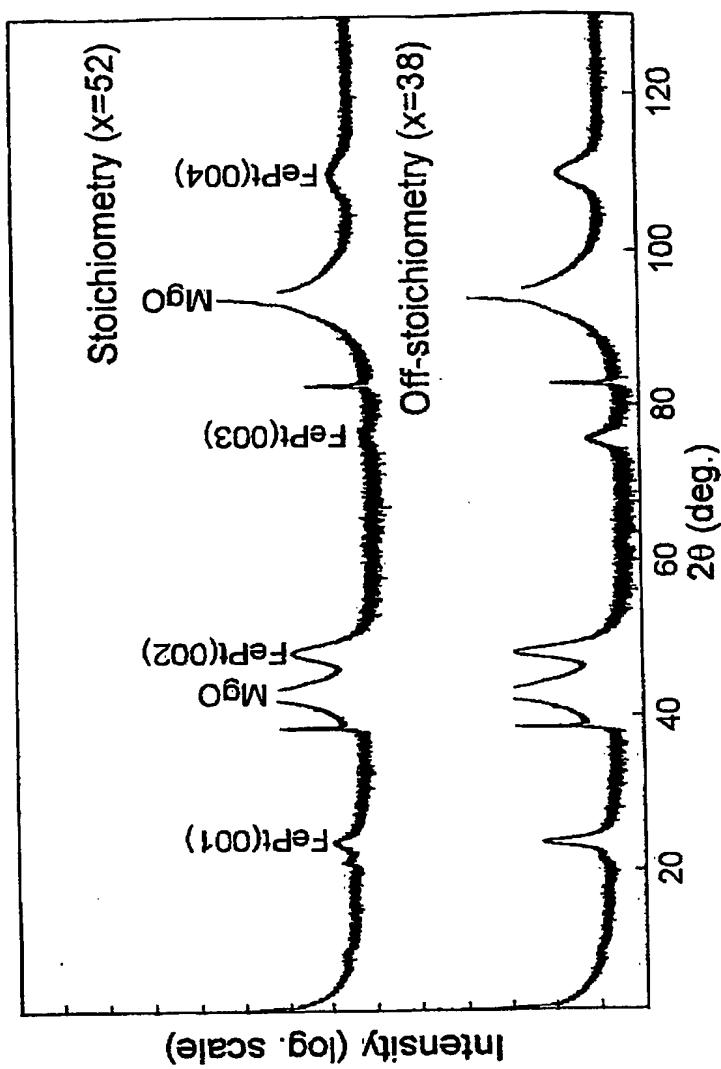


【図8】

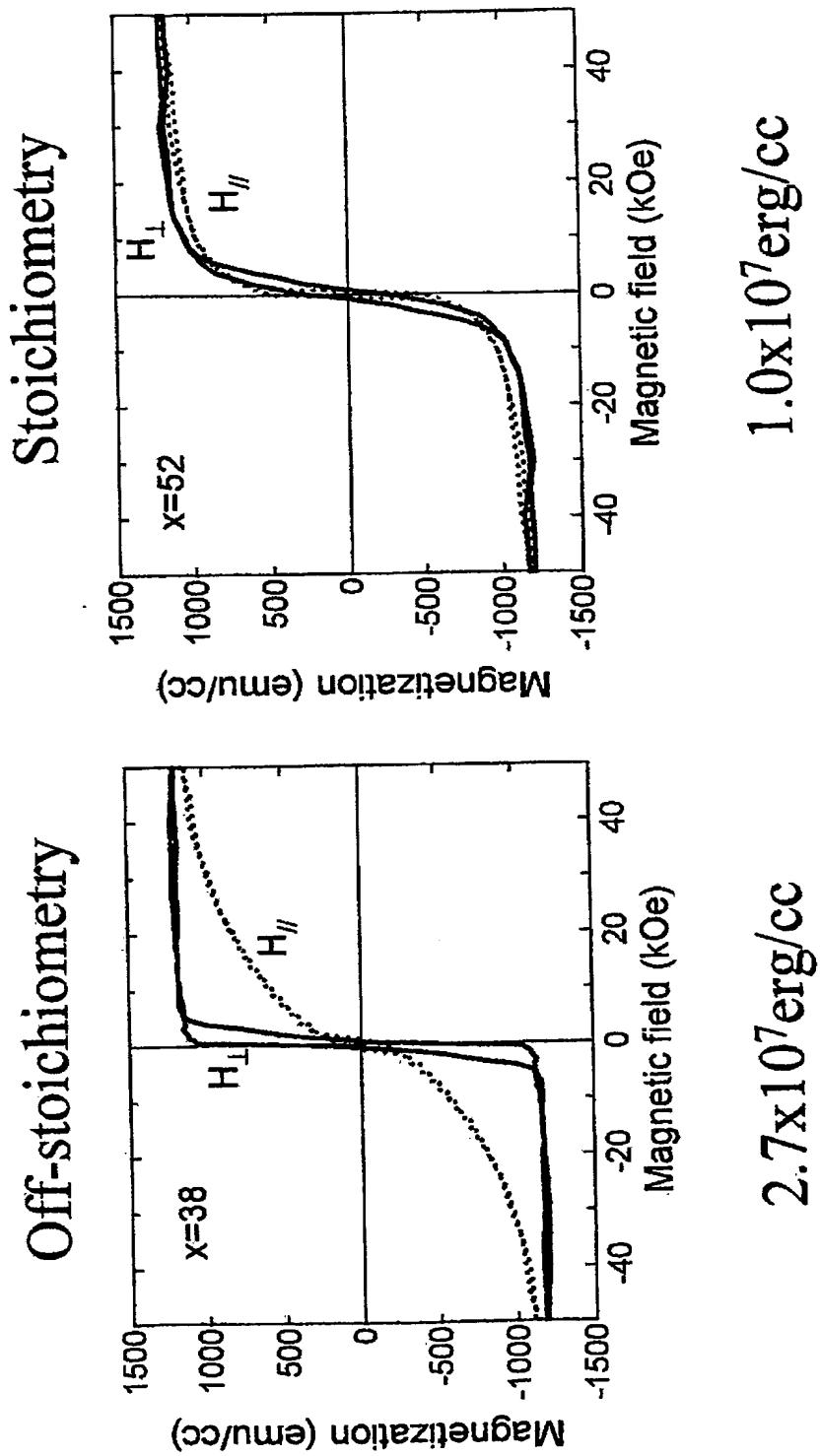
$Fe_{38}Pt_{62}$ (18nm) / Au (40nm) / Fe (1nm) / MgO(001)



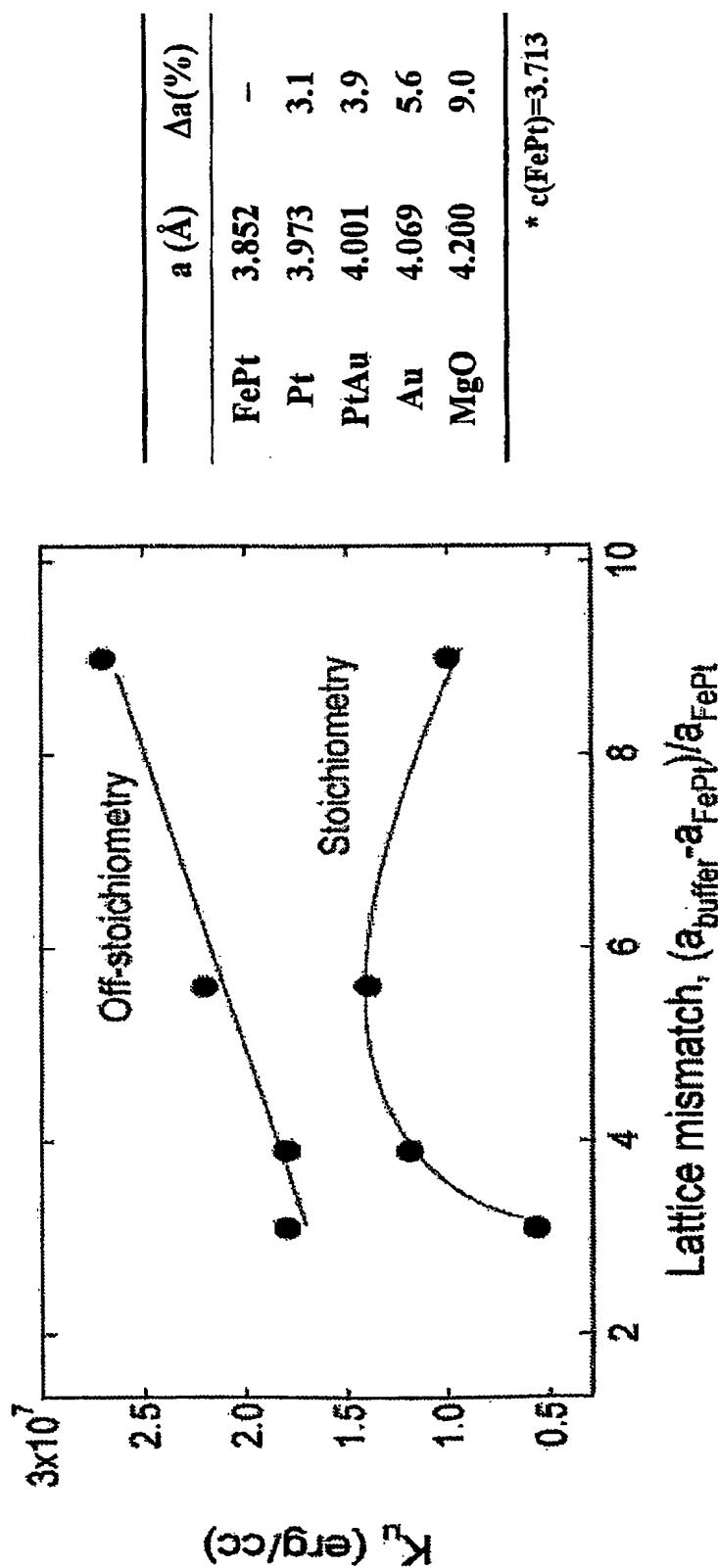
【図6】



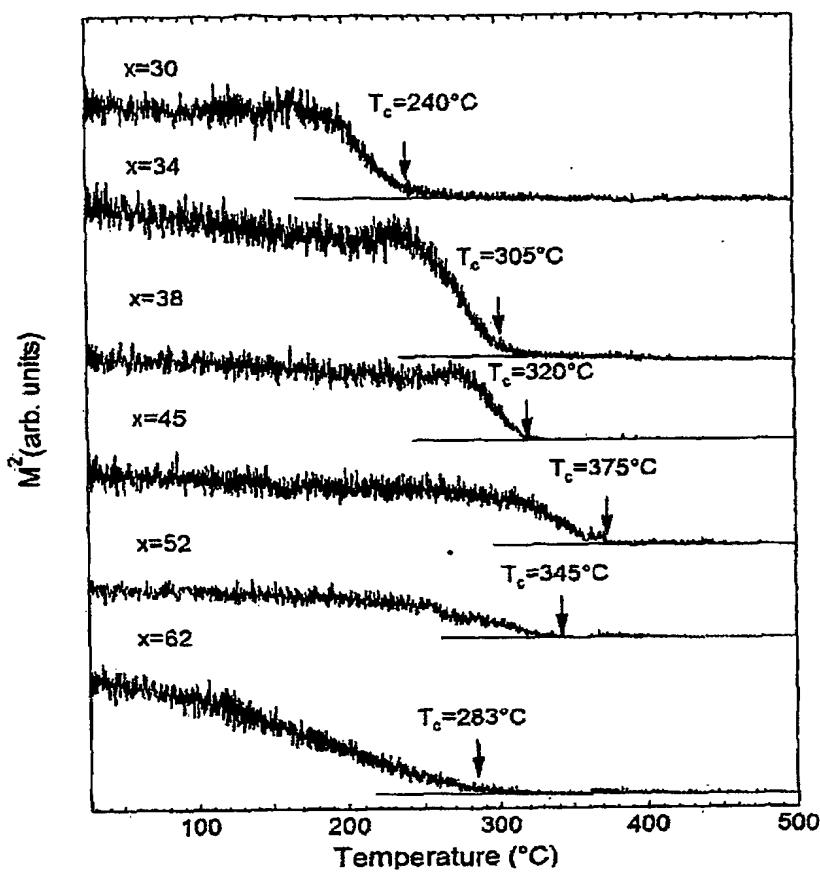
【図10】



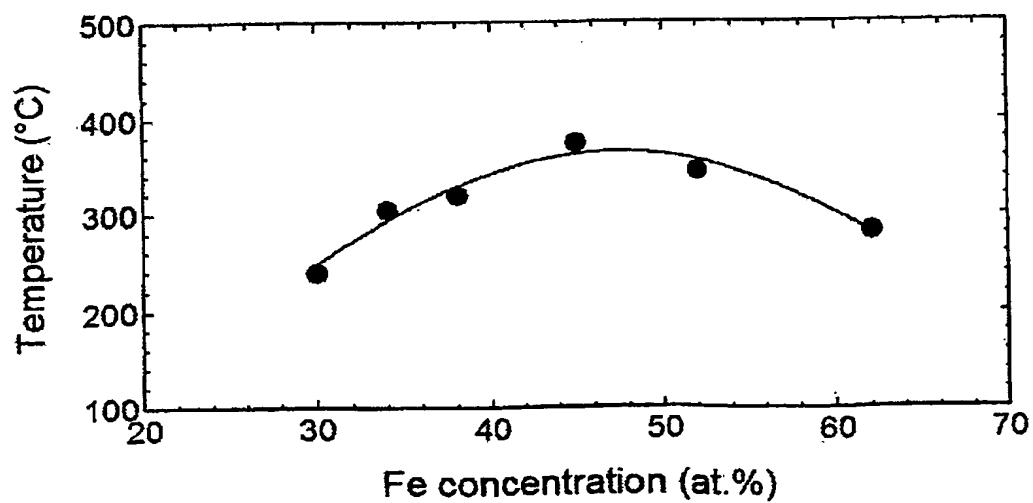
【図11】



【図12】



【図13】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 より低い温度での成膜が可能とされ、しかも垂直磁気異方性を有する新しいFe Pt磁性薄膜とその製造方法を提供する。

【解決手段】 原子組成比が、次式

Fe_xPt_{100-x}

(19 < x < 52)

で表わされるFePt磁性薄膜とする。

【選択図】図2

特願2003-313158

出願人履歴情報

識別番号

[301023238]

1. 変更年月日 2001年 4月 2日

[変更理由] 新規登録

住 所 茨城県つくば市千現一丁目2番1号
氏 名 独立行政法人物質・材料研究機構